

程序已使其受到損壞，而且此氧化層厚度對目前的技術來說也太厚，所以我們再成長一層約 15 到 50Å 之薄氧化層，稱之為閘極氧化層，如圖 6-17 所示。

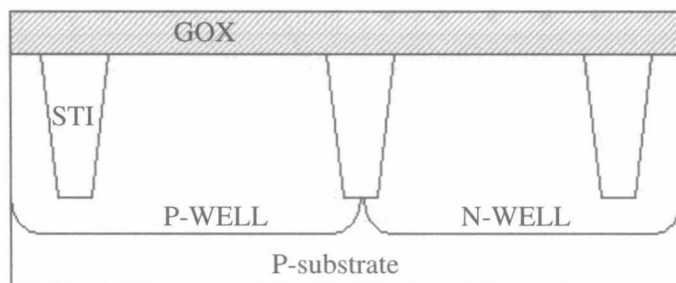


圖 6-17 Gate Oxide 之成長。

4. 多晶矽閘極 (Poly-silicon Gate) 之製程

此製程的主要目的就是將電晶體的閘極結構形成，主要步驟分別是：

(1) 沉積一層未摻雜多晶矽 (undoped Poly-Si) ，如圖 6-18 所示。

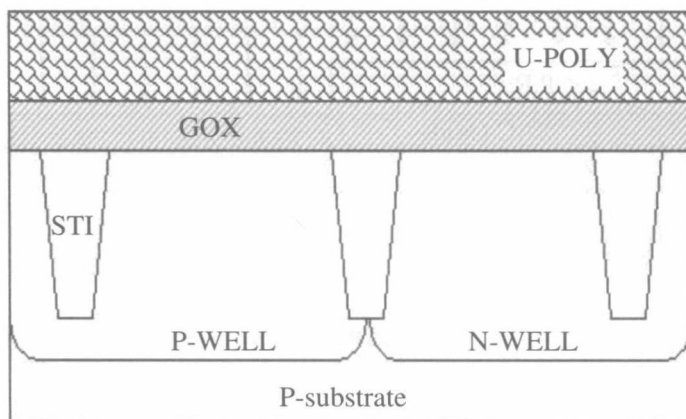


圖 6-18 未摻雜多晶矽 (U-poly) 沉積。

(2) 高濃度 N 型多晶矽 (N^+ Poly-Si) 之微影及五價的原子植入，如圖 6-19 所示。最後再把光阻移除。